

Фамилия, имя, отчество	Осипов Юрий Васильевич
Должность, ученая степень, ученое звание	Доцент, к.ф.-м.н.
Электронная почта	osipov@misys.ru
Рабочий телефон	+7 499 237-21-29
Область научных интересов	Физика межфазных явлений. Моделирование многослойных структур и процессов их получения. Радиационное воздействие на полупроводниковые материалы и приборы на их основе. Физика полупроводников
Трудовая деятельность	В 1984 года избран ассистентом кафедры материаловедения полупроводников МИСиС, а затем последовательно избирался старшим преподавателем (1989 г.) и доцентом (1991 г.). В 1984 году был назначен начальником 1 курса факультета Полупроводниковых материалов и приборов (ПМП), в 1988 году – заместителем декана факультета ПМП, в 1995 году – деканом факультета ПМП, в 2006 – 2022 годах – заместителем директора Института новых материалов и нанотехнологий НИТУ «МИСиС», одновременно – заведующим кафедрой Полупроводниковой электроники и физики полупроводников (с 2002 года по 2016 год)
Образование	В 1972 году окончил физико-математический факультет (отделение «Физика») Кабардино-Балкарского Государственного университета по специальности «Физика». В 1973 году поступил в очную аспирантуру МИСиС. В 1981 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. В 1992 году присвоено звание доцента.
Основные результаты деятельности	Член Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи». Член Научно-методического совета по направлению подготовки бакалавров и магистров «Электроника и нанoeлектроника». 1997 г. – награжден медалью «850 лет Москвы». 1999 г. – Почетный работник высшего профессионального образования РФ. 2000 г. – серебряный знак МИСиС. 2005 г. Медаль за безупречную службу МИСиС. 2009 г. - золотой знак МИСиС.
Значимые проекты, гранты	Наименование темы: Проведение материаловедческих исследований, направленных на создание ПАВ-сенсоров на пьезокристаллических подложках. Наименование темы: Исследование влияния толщины слоя ПСР–72 на структуру и состав фаз на границе раздела “титан – сапфировая подложка” Наименование темы: Создание элементов высокотемпературных датчиков на основе монокристаллов лантангаллиевого силиката
Значимые публикации	1. Orlova, M., Abdullaev, O., Mezheny, M., Chelny, A.;

	Savchuk, A.; Ermoshin, I.; Rabinovich, O.; Didenko, S.; Osipov, Yu.; Kourova, N., Akhmerov, Y., Marenkin, S. Influence of Growth Parameters on a-Plane InGaN/GaN Heterostructures on r-Sapphire. Physica Status Solidi (B) Basic Research, 2019, 256(5), 1800371 2. Orlova, M., Abdullaev, O., Mezheny, M., Chelny, A., Savchuk, A., Ermoshin, I., Rabino-vich, O., Didenko, S., Osipov, Y., Kourova, N., Akhmerov, Y., Marenkin, S. Influence of Growth Parameters on a-Plane InGaN/GaN Heterostructures on r-Sapphire. Phys. Status Solidi B, 2019, 18003711(7pp) 3. Oleg Rabinovich, Sergey Legotin, Sergey Didenko, Evgeniy Yakimov, Yuriy Osipov, and Irina Fedorchenko “Heterostructure optimization for increasing LED efficiency” // Jap-anese Journal of Applied Physics, № 55, pp. 05FJ131 - 05FJ134, 2016 4 Rabinovich, O., Legotin, S., Didenko, S., (...), Osipov, Y., Fedorchenko, I. Heterostruture optimization for increasing LED efficiency. 2016 Japanese Journal of Applied Physics. 55(5).05Fj13
Индекс Хирша по Scopus Количество статей по Scopus На усмотрение: SPIN РИНЦ ORCID ResearcherID Scopus AuthorID	8,9 102
Значимые патенты	
Научное руководство /Преподавание	Читаемые дисциплины «Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники» Научное руководство Бакалавры, магистры